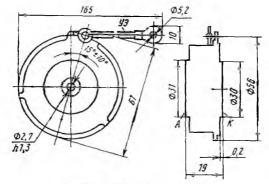
Тиристор кремииевый диффузионный p-n-p-n. Предназначен для применения в статических преобразователях электропривода постоянного и переменного токов частотой до 500 Γ ц и других силовых установках преобразования электроэнергии. Выпускается в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции. Анодом и катодом служат плоские основания. Обозначение типономинала и полярности приводится на керамическом изоляторе и на бирке. Масса не более 150 г.



Электрические параметры

Импульсное напряжение в открытом состоянии при	
$I_{\text{ос. u}} = 3.14 I_{\text{ос. cp. max}}, t_{\text{u}} = 10$ мс не более	1,85 B
Пороговое напряжение не более	0, 96 B
Пороговое напряжение не более . Отпирающее постоянное напряжение управления при	,
$U_{ac} = 12 \text{B}$ не более:	
$T_{\rm H} = -50$ °C. $I_{\rm N} = 0.8$ A	9 B
$T_{\rm g} = 25^{\circ}{\rm C}$ $I_{\rm N} = 25^{\circ}{\rm A}$	5 B
$T_{\pi} = 25^{\circ}\text{C}, I_{y, \text{or}} = 0,3 \text{ A}$ $T_{\pi} = 125^{\circ}\text{C}, I_{y, \text{or}} = 0,2 \text{ A}$	2,5 B
Неотпирающее импульсное напряжение управления прн	2,0 2
$U_{3c, H} = U_{3c, \Pi}$, $R_y = 20$ OM, $T_{\Pi} = 125$ °C He MeHee	0,5 B
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии	-,-
при $U_{3c, \mu} = U_{3c, \pi}$, $R_y = \infty$, $T_{\pi} = 125$ °C не более	15 мА
Ток удержания при $U_{\rm ac}=12$ В, $R_{\rm y}=\infty$ не более	0,15 мА
Ток включения при $I_v = 1$ A, $di_v/dt = 1$ A/мкс, $t_v = 5$ мкс	0,10
	0,35 A
не более	-,
$U_{\text{обр. и}} = U_{\text{обр. п}}, R_{\text{y}} = \infty, T_{\text{п}} = 125 ^{\circ}\text{С}$ не более	15 мА
Обратный ток восстановления при $U_{\text{обр, H}} = 100 \text{ B}$,	
$I_{\text{oc, H}} = I_{\text{oc, cp max}}$, $(di_{\text{oc}}/dt)_{\text{cn}} = 8 \text{ A/MKC}$, $T_{\text{n}} = 125 \text{ °C}$	
не более	325 A
не более	
не более:	
$T_{\rm n} = -50$ °C	0.8 A
$T_n = 25$ °C	0,3 A
$T_{\pi} = 25$ °C	0,2 A
Неотпирающий постоянный ток управления при $U_{3c, n} =$	-,-
$=U_{3c, \pi}$, $R_y=20$ OM, $T_{\pi}=125$ °C He MeHee	15 mA
Время включения при $U_{3c} = 100$ В, $I_{oc, \mu} = I_{oc, cp max}$,	
$I_y = 1$ A, $di_y/dt = 1$ А/мкс, $t_y = 50$ мкс ие более	30 мкс
Время задержки при $U_{3c} = 100$ В, $I_{oc, n} = I_{oc, cp max}$,	33
$I_y = 1$ A, $di_y/dt = 1$ А/мкс, $t_y = 50$ мкс не более	5 мкс
Время выключения при $U_{3c, u} = 0.67 U_{3c, u}$, $du_{3c}/dt =$	o mile
$= (du_{3c}/dt)_{Kp}, U_{06p, N} = 100 B, I_{0c, N} = I_{0c, cp max},$	
$(di_{0c}/dt)_{cn} = 5$ A/MKC, $T_n = 125$ °C не более:	
	250 мкс
rpyma 1	150 MKC
группа 2	100 MKC
	70 MKC
группа 4	10 MKC

Время обратного восстановления при $U_{\rm ofp,\;n}=100$ В, $I_{\rm oc,\;u}=I_{\rm oc,\;cp\;max},\;(di_{\rm oc}/dt)_{\rm cu}=5$ А/мкс, $T_{\rm n}=125$ °C не более	20 мкс 440 мкКл 1,2 мОм 0,057 °C/Вт
Предельные эксплуатационные данные	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии Максимально допустимое постоянное иапряженне в закрытом состоянии Повторяющееся импульсное обратное напряжение Неповторяющееся импульсное обратное напряжение Максимально допустимое постоянное обратное напряжение жение	400—1600 B 1,12 U _{3c, π} B 0,8 U _{3c, π} B 0,75 U _{3c, π} B 400—1600 B 1,12 U _{06p, π} B 0,75 U _{06p, π} B
жение	U,73 U 0 6 p, 11 D
группа 1 . группа 2 . группа 3 . группа 4 . группа 5 . группа 6 .	20 В/мкс 50 В/мкс 100 В/мкс 200 В/мкс 500 В/мкс 1000 В/мкс
Максимально допустимое обратное постоянное напряжение управления	0,5 B 250 A 400 A 5500 A
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии при $U_{3c, n} = U_{3c, n}$, $I_{oc, n} = 2$ $I_{oc, cp max}$, $di_y/dt = 1$ A/MKC, $f = 1$ —5 Γ ц, $t_y = 50$ мкс, $T_n = 125$ °C:	100 KAC
группа 1	20 A/mkc 40 A/mkc 70 A/mkc 100 A/mkc 200 A/mkc
Минимально допустимый прямой импульсный ток управления	1 A 10 A

Температура перехо	да						От —50 до +125°C
Температура корпус	а.	. •			•	•	От -50 до + 125°C

Типономиналы допускают произвольное сочетание классификационных параметров

Указания по монтажу

Таблеточный корпус тиристора соединяется с охладителем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего хороший электрический и тепловой контакт во всем диапазоне рабочих температур. Сборка тиристора должна производиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Неплоскостность контактных поверхностей, вкладышей и охладителей не более 0.01, чистота обработки не хуже 2.5.

охладителей не более 0,01, чистота обработки не хуже 2,5. Не допускается эксплуатация тиристора без обеспечения необходимого внешнего сжатия со стороны оснований в диапазоне 8 000—

12 000 H.

